
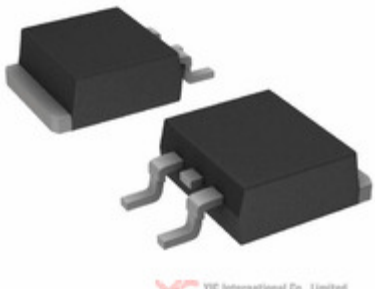
	<p>SQM110P06-8M9L_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQM110P06-8M9L_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 110A TO263</p> <p>Datenblätter:  SQM110P06-8M9L_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQM110P06-8M9L_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 110A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D ² Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.9 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	230W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	200nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 110A (Tc) 230W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

SQM110P06-8M9L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM110P06-8M9L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM110P06-8M9L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM110P06-8M9L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM120N04-02L-GE3 VISHAY SQM120N04-02L-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQM120N03-1M5L-GE3 VISHAY SQM120N03-1M5L-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQM120N03-1M5L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 120A TO-263</p>	 <p>SQM110P04-04L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 120A TO263</p>
 <p>SQM110N06-06-GE3 VB SQM110N06-06-GE3 VB</p>	 <p>SQM120N03-1M5L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 120A TO-263</p>	 <p>SQM110P06-07L-GE3 VISHAY SQM110P06-07L-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQM110N06-04L-GE3 VB SQM110N06-04L-GE3 VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM110P06-8M9L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM110P06-8M9L_GE3 Datenblatt	SQM110P06-8M9L_GE3-Datenblätter	SQM110P06-8M9L_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQM110P06-8M9L_GE3 Electronic	SQM110P06-8M9L_GE3-Komponenten	SQM110P06-8M9L_GE3-Verteiler	SQM110P06-8M9L_GE3-Bild	SQM110P06-8M9L_GE3-Teil
SQM110P06-8M9L_GE3 Preis	SQM110P06-8M9L_GE3 Hersteller	SQM110P06-8M9L_GE3 Bild	SQM110P06-8M9L_GE3 Aktie	SQM110P06-8M9L_GE3 Inventar
SQM110P06-8M9L_GE3 Neu	SQM110P06-8M9L_GE3 Original	SQM110P06-8M9L_GE3 garantiert	SQM110P06-8M9L_GE3 RFQ	SQM110P06-8M9L_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited